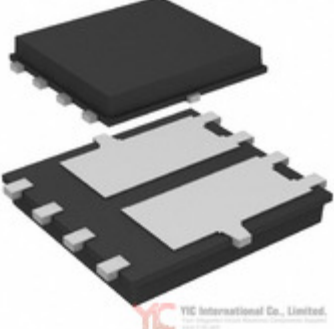


	<h2 style="color: #E67E22;">SISB46DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISB46DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 40V POWERPAK 1212-8
	Datenblätter:  SISB46DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


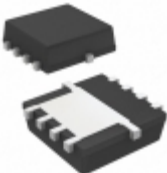

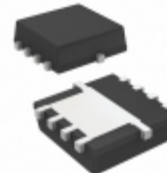

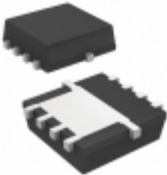
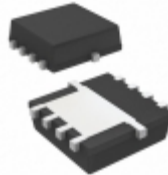
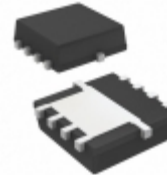
Spezifikationen

Teilenummer	SISB46DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 40V POWERPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.71 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	23W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SISB46DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 34A (Tc) 23W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	34A (Tc)

SISB46DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISB46DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISB46DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISB46DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISC097N24DX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) TRANSISTOR P-CH BARE DIE</p>	 <p>SISC06DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V</p>	 <p>SISA96DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 1212-8</p>	 <p>SISA96DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A POWERPAK1212</p>
 <p>SISC050N10DX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHAN SAWED WAFER</p>	 <p>SISA72DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAK1212</p>	 <p>SISA66DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAK1212</p>	 <p>SISA72DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISB46DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISB46DN-T1-GE3 Datenblatt	SISB46DN-T1-GE3-Datenblätter	SISB46DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISB46DN-T1-GE3
SISB46DN-T1-GE3 Electronic	SISB46DN-T1-GE3-Komponenten	SISB46DN-T1-GE3-Verteiler	SISB46DN-T1-GE3-Bild	SISB46DN-T1-GE3-Teil
SISB46DN-T1-GE3 Preis	SISB46DN-T1-GE3 Hersteller	SISB46DN-T1-GE3 Bild	SISB46DN-T1-GE3 Aktie	SISB46DN-T1-GE3 Inventar
SISB46DN-T1-GE3 Neu	SISB46DN-T1-GE3 Original	SISB46DN-T1-GE3 garantiert	SISB46DN-T1-GE3 RFQ	SISB46DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited